

УТВОРЕННЯ ЕКСИМЕРНИХ МОЛЕКУЛ KrF* В ПЛАЗМОВИХ СТРУЯХ НА СУМІШАХ He-Kr-F₂ і He-Kr-SF₆

Богачова С.П., Рогулич В.С., Шевера В.С.

ВСТУП

У зв'язку з проблемою створення ексимерних лазерів неперервної дії викликають інтерес експериментальні і теоретичні дослідження ексимерних молекул в плазмовій струї. Фізичною основою для цього є те, що при розльоті плазми температура її складових компонент швидко зменшується і створюються сприятливі умови для протікання іон-іонної рекомбінації - одного з найважливіших процесів утворення ексимерних молекул. Вперше експерименти по одержанню ексимерних молекул в неперервній плазмовій струї, зокрема на галогенідах інертних газів, були виконані в Ужгородському університеті [1,2].

В даній праці проведено моделювання плазмодинамічної струї і виконано розрахунки параметрів і характеристик плазми на газових сумішах He-Kr-F₂ і He-Kr-SF₆ з метою виявлення оптимальних умов утворення найбільш важливої ексимерної молекули KrF*.

1. МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАЗМИ І КОНСТАНТИ ПРОЦЕСІВ

Ми базувались на слідуючих експериментальних даних [1,2]: - концентрація компонент плазми N_{Kr}, N_{SF₆}, N_{F₂}=10¹⁴...10¹⁶ см⁻³, N_{He}=10¹⁶...10¹⁹ см⁻³ - електронна температура Te~T_{gas}=0,4...1,2 еВ.

Розглядається стаціонарне розширення плазми з швидкістю більше 10⁵ см·с⁻¹, за початковий момент розльоту прийнято 10⁻⁵ с. Для спрощення ми приймаємо, що в соплі плазмотрона струмінь вільно розширюється у двох вимірах простору (константа розширення m=2), а після виходу поширюється по циліндричному каналу (m=1).

Кінетику процесів зіткнення частинок будемо описувати на основі системи диференціальних рівнянь

$$\frac{dN_m}{dt} = \sum K_{mm'} \cdot N_m - \mu \frac{N_m}{t}, \quad (1)$$

де K_{mm'} - швидкість реакцій зіткнення з участию m і m' частинок плазми, N_m - концентрація m-сорту частинок плазми, t - константа розширення плазми.

Член $\mu \frac{N_m}{t}$ враховує розліт плазми в часі t. В робочих газових сумішах He-Kr-F₂ і He-Kr-SF₆ врахована релаксія в часі 15 сортів частинок m=Kr, Kr⁻, Kr⁺, Kr₂⁺, Kr₂⁻, KrF^{*}, Kr₂F^{*}, F₂, F, F⁻(SF₆, SF₆⁻, SF₅⁻), He⁺, He*, He₂⁺, He₂⁻ і електронів.

Спільно з системою рівнянь (1) розглядалась динаміка балансу тепла електронної і газових компонент плазми, аналогічно як і в роботі [3]. Система диференціальних рівнянь (1) інтегрувались методом Гіра. Швидкість реакцій частинок K_{mm'} для трьохкомпонентної He-Kr-F₂ плазми взяті із праць [3,4,5]. Для He-Kr-SF₆ плазми константи швидкості реакцій розраховувались нами самостійно і зведені в таблиці 1.

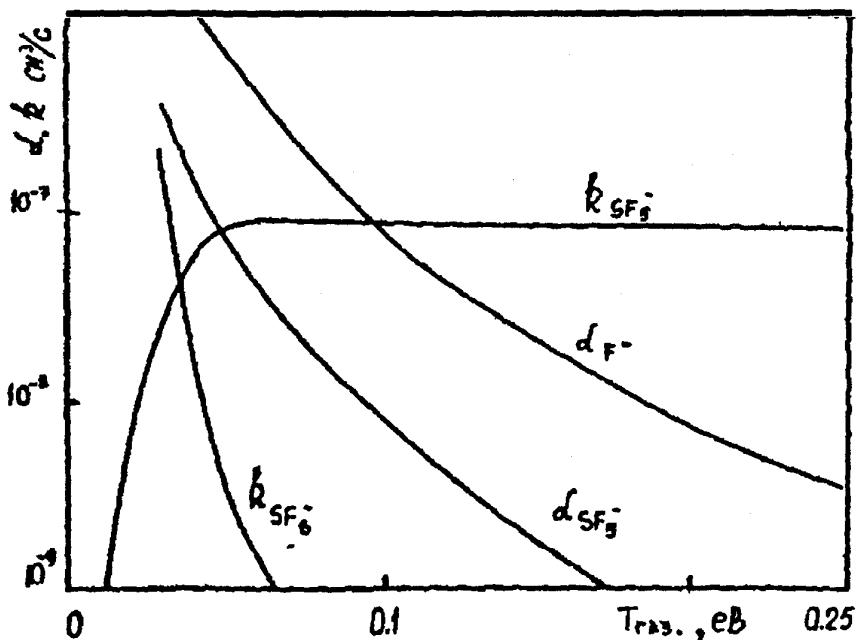
Таблиця 1

Основні процеси в плазмовій струї на суміші газів He-Kr-SF₆

№п/п	Процеси	Константа см ³ /с, см ⁶ /с	Літера -тура
1.	$\left\{ \begin{array}{l} \text{SF}_6^- \\ \text{SF}_5^- \\ \text{F}^- \end{array} \right\} + \text{Kr} \rightarrow \text{KrF}^+ + \text{п ро.}$	розрахунок по Фланнері	6
2.	$\text{Kr}^+ + \text{SF}_6 @ \text{Kr}^+ + \text{SF}_5$	$2.5 \cdot 10^{-10}$	10
3.	$\text{Kr}^+ + \text{F}^- + \text{He} @ \text{Kr}^+ + \text{He}$	$5 \cdot 10^{-32}$	3
4.	$\text{Kr}^+ + \text{F}^- @ \text{Kr}^+ + \text{Kr}$	$4 \cdot 10^{-9} / \text{Te}^{1.5}$	3
5.	$\text{Kr}^+ + \text{F}^- @ \text{KrF}^+ + \text{Kr}$	$3 \cdot 10^{-10}$	3
6.	$\text{Kr}^+ + \text{F}^- @ \text{KrF}^+ + \text{e}$	$2 \cdot 10_{-9}$	3
7.	$\text{e} + \text{SF}_6 \left\{ \begin{array}{l} \text{SF}_6^- \\ \text{SF}_5^- \\ \text{F}^- \end{array} \right\} + \text{п ро.}$	$1.8 \cdot 10^{-8} / \text{Te} (1\text{-CK})$ $1.8 \cdot 10^{-8} / \text{Te CK}$ $4 \cdot 10^{-10}$ $\text{CK} = \frac{N_{\text{SF}_5^-}}{N_{\text{SF}_6^-}} = 700 \cdot (T_{\text{Г аз}} (\text{эВ}) \cdot 10)$	7, 8, 9
8.	$\text{F}^- + \text{e} @ \text{F} + 2\text{e}$	$3.5 \cdot 10^{-7} / \text{Te}$	3
9.	$\text{F}^- + 2\text{e} @ \text{F}^- + \text{e}$	$9 \cdot 10^{-28} / \text{Te}^{2.25}$	3
10.	$\text{F}^- + \text{F} + \text{He} @ \text{F}_2 + \text{He}$	$1 \cdot 10^{-34}$	4
11.	$\text{Kr}^+ + \text{Kr} + \text{He} @ \text{Kr}_2^+ + \text{He}$	$1 \cdot 10^{-31}$	4
12.	$\text{Kr}^+ + \text{Kr} + \text{He} @ \text{Kr}_2^+ + \text{He}$	$5 \cdot 10^{-32}$	4
13.	$\text{He}_2 + \text{Kr} @ \text{Kr}^+ + 2\text{He}$	$1.85 \cdot 10^{-11}$	4
14.	$\text{He}^+ + \text{Kr} @ \text{Kr}^+ + \text{He} + \text{e}$	$1 \cdot 10^{-10}$	3
15.	$\text{He}^+ + \text{Kr} + \text{He} @ \text{Kr}^+ + 2\text{He} + \text{e}$	$0.86 \cdot 10^{-30}$	3
16.	$\text{He}_2^+ + \text{Kr} @ 2\text{He} + \text{Kr}^+ + \text{e}$	$1 \cdot 10^{-10}$	3
17.	$\text{He}_2^+ + \text{Kr} + \text{He} @ 3\text{He} + \text{Kr}^+ + \text{e}$	$0.86 \cdot 10^{-30}$	3
18.	$\text{Kr}_2^+ + \text{F}^- + \text{He} @ \text{Kr}_2\text{F}^+ + \text{e}$	$1 \cdot 10^{-25}$	3
19.	$\text{Kr}_2^+ + \text{F}^- \text{Kr}_2\text{F}^+ + \text{e}$	$2 \cdot 10^{-9}$	3
20.	$\text{KrF}^+ + \text{Kr} + \text{Kr} @ \text{Kr}_2^+ + \text{F}^- + \text{Kr}$	$3 \cdot 10^{-36} / T^{-3.5}$	3
21.	$\text{KrF}^+ + \text{Kr} + \text{He} @ \text{Kr}_2\text{F}^+ + \text{He}$	$5 \cdot 10^{-31}$	4
22.	$\text{KrF}^+ @ \text{KrF} + \text{hn}$	$t = 6.5 \cdot 10^{-9}$	4
23.	$\text{KrF}^+ + \text{e} @ \text{Kr} + \text{F} + \text{e}$	$3.5 \cdot 10^{-8}$	3
24.	$\text{KrF}^+ + \text{SF}_6 @ \text{Kr} + \text{F} + \text{SF}_6$	$1 \cdot 10^{-11}$	5, 4
25.	$\text{KrF}^+ + \text{Kr} @ \text{Kr} + \text{FKr}$	$1 \cdot 10^{-12}$	5, 4
26.	$\text{KrF}^+ + \text{F}^- @ \text{Kr} + 2\text{F} + \text{e}$	$2 \cdot 10^{-9}$	3
27.	$\text{Kr}_2\text{F}^+ + \text{e} @ 2\text{Kr} + \text{F} + \text{e}$	$3.5 \cdot 10^{-8}$	3
28.	$\text{Kr}_2\text{F}^+ + \text{F}^- @ 2\text{Kr} + 2\text{F} + \text{e}$	$2 @ 10^{-9}$	5

Коефіцієнти іон-іонної рекомбінації α для процеса (1) розраховані по формулі Фланнері-Натансонса [6], а константи швидкості утворення від'ємних іонів для процесів

(7) одержано при обробці даних із праць [7-9]. Температурні залежності α і k приведені на мал.1. Із цих даних випливає, що $k_{SF_5^-}$ досить високою в інтервалі 0,05-0,25 еВ і це може свідчити про важливу роль електронегативного іону SF_5^- в утворенні ексимерної молекули.

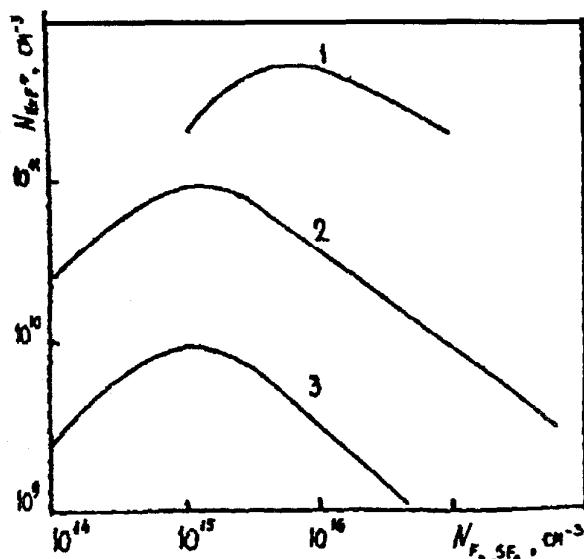


Мал.1. Температурні залежності коефіцієнтів іон-іонної рекомбінації $\alpha_{F_+ + Kr^+}$ та $\alpha_{SF_5 + Kr^+}$ і швидкостей утворення від'ємних іонів (при $T_e = 0,2 \text{ еВ}$) N_{SF_5} та k_{SF_6} для N плазми= $2,69 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$.

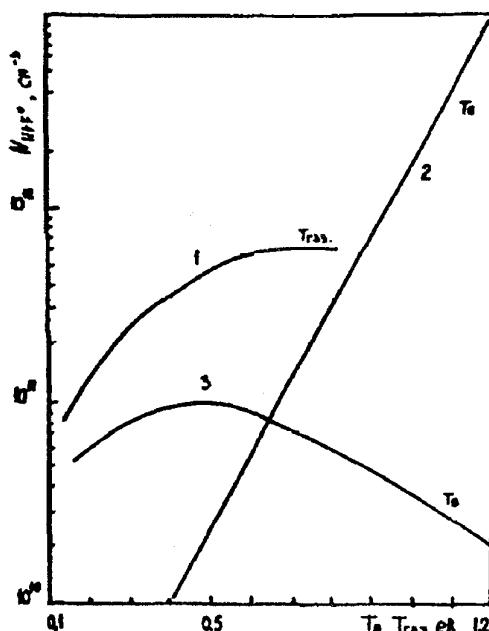
2. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ми приведемо основні результати, які описують вихід ексимерних молекул в газових сумішах He-Kr-F₂ і He-Kr-SF₆ в залежності від концентрації галогеноносіїв і електронної та газової температури.

Залежність густини ексимерних молекул Kr^{*} від концентрації F₂ і SF₆ приведено на мал.2. Ці дані показують, що вихід KrF^{*} в суміші He-Kr-SF₆ є більшим для He-Kr-G₂F₅. Ефективне утворення KrF^{*} лежить в інтервалі концентрацій галогеноносіїв $2 \cdot 10^{15} \dots 8 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$. Виявлено, що оптимальна концентрація F₂ приблизно рівна концентрації електронів в плазмі. Це пояснюється тим, що практично всі електрони з малими енергіями приймають участь в утворенні від'ємних іонів F⁻ при зіткненні з молекулами F₂. Якщо ж збільшувати долю F₂, то зростання кількості F⁻ та KrF^{*} не спостерігається, а навпаки - концентрація KrF^{*} зменшується, із-за тушачих зіткнень KrF^{*} з молекулами F₂. Аналогічні процеси відбуваються і в He-Kr-SF₆ плазмовій суміші.



Мал.2. Залежність концентрації ексимерних молекул в плазмовій струї від початкової концентрації галогеноносіїв SF_6 і F_2 для He-Kr-SF₆ плазми (крива 1) та He-Kr-F₂ плазми (крива 2- $N_{Kr}=3,4\cdot 10^{17}\text{ см}^{-3}$, крива - 3- $N_{Kr}=3,4\cdot 10^{16}\text{ см}^{-3}$)



Мал.3. Температурні залежності Krf^* криві 1 і 2 для He-Kr-SF₆, крива 3 для He-Kr-F₂.

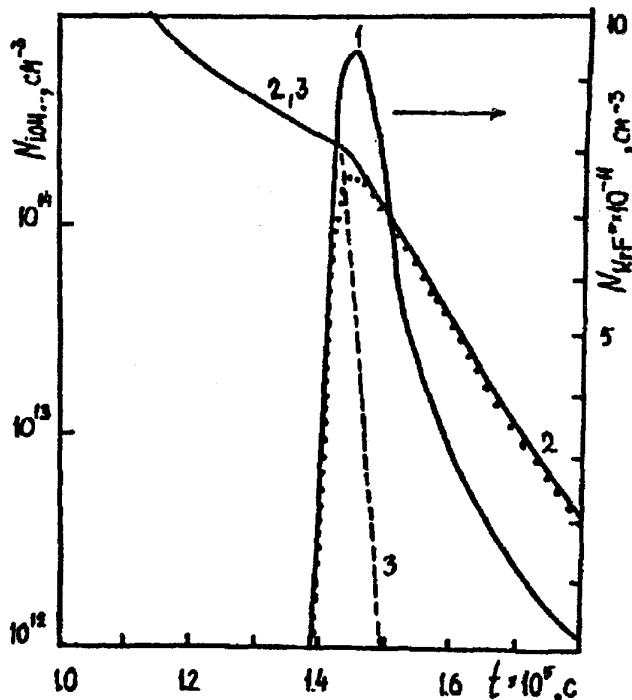
Не приводячи конкретних даних замітимо, що зростання концентрації кріптона у плазмі приводить до росту кількості Krf^* , у зв'язку з збільшенням концентрації Kr^+ .

Залежність густини ексимерних молекул Krf^* від початкової температури електронів Te та важких частинок плазми $T_{\text{газ}}$ подано на мал.3. Для плазми на суміші He-Kr-SF₆ вихід ексимерних молекул є оптимальним в інтервалі $T_{\text{газ}}=0,5-0,9$ ев (крива 1) і різко зростає від Te (крива 2). При малих газових температурах в плазмотронному соплі електронна температура може знизитись до таких значень, щоб електрони ефективно прорекомбінували з іонами плазми, в результаті чого за соплом умови для утворення ексимерних молекул Krf^* не будуть оптимальними. Підвищення $T_{\text{газ}}$ до значень більших 0,9 ев є також не бажаним, поскільки в плазмі сповільнюються процеси іон-іонної рекомбінації.

Однак, для плазми на суміші He-Kr-F₂ збільшення Te не приводить до зростання N_{Krf^*} (крива 3, мал.3). Це пояснюється тим, що швидкість утворення іонів F^- при зіткненні електронів з молекулами F_2 менше, ніж при зіткненні електронів з SF_6 . Тому концентрація електронів в He-Kr-F₂ плазмі довгий час залишається досить великою, а електрони дуже ефективно гасять молекули Krf^* .

Накінець розглянемо часову динаміку важливих компонент плазмової струї. Детально результати розрахунків приведені на мал.4.

В He-Kr-SF₆ плазмі (мал.4а), внаслідок великої константи тіворення від'ємних іонів (7, табл.1), накопичуються SF_5^- і F^- , при цьому концентрація їх в часі зменшується на кілька порядків. Із-за швидкого витрачання іонів Kr^+ і SF_6^- крива (1) для N має вузький максимум. У зв'язку з цим галогеноносій SF слід вводити у He-Kr плазмову струю після виходу плазми із сопла.



Мал.4. Часова релаксація основних компонент He-Kr-SF₆ плазми (а)
та He-Kr-F₂ плазми (б)
1-N_{KrF*}, 2-N_{Kr+}, 3-N електр., 4-N_F. 10³, позначено ...-N_{SF5..}

В He-Kr-F₂ плазмі (мал.4б) від'ємні іони накопичуються повільніше, тому крива (1, мал.4б) для KrF^{*} має більш погоджий максимум.

Таким чином, підсумовуючи результати розрахунків приходимо до висновку, що при одинакових початкових параметрах в He-Kr-SF₆ плазмовій струї утворюється більше ексимерних молекул KrF^{*}, ніж у суміші He-Kr-F₂. У зв'язку з цим така газова суміш може бути перспективною для одержання більш високих концентрацій KrF^{*} ніж було одержано раніше в роботі [2]. Для одержання в плазмовій струї концентрації ексимерних молекул більше 10¹² см⁻³ рекомендується вибрати слідуючі параметри:

- N_{Kr}>5 10¹⁶ см⁻³,
- N_{SF6}≈ початковій концентрації електронів,
- N_{He}>10¹⁸ см⁻³,
- Te>1 ев, T_{газ}>0,5 ев.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шевера В.С., Рогулич В.С., Стародуб В.П. Излучение эксимеров KrF^{*} и XeF^{*} в плазменной струе.- Письма в ЖТФ, 1986, т.12, вып.10, с.606-609.
2. Рогулич В.С., Стародуб В.П., Шевера В.С. Об эффективности образования эксимерных молекул в плазменной струе на смесях инертных газов с SF₆ и CCl₄.- ЖТФ, 1988, т.58, вып.10, с.1893-1896.
3. Лакоба С.Н., Сыцько Ю.И., Якубцева Е.Д. Численное моделирование локальной кинетики релаксации среды KrF - лазера.- Труды ФИАН, 1984, т.145, с.131-159.
4. Молчанов А.Г. Теория активных эксимерных лазеров.- Труды ФИАН, 1986, т.171, с.54-1267.
5. Эксимерные лазеры. Под ред. Ч.Роуза.- М.: Мир, 1981.
6. Лакоба И.С., Сучкова Е.Д., Сыцько Ю.И. Вычисление коэффициентов ион-ионной рекомбинации с учетом температурной зависимости. - Препринт ФИАН, 1981, N8, с.1-33.
7. Газовые лазеры под ред. И.Мак-Даниэля. М.: Мир, 1986, с.552.

8. Chan C.L., Chantry P.J. Photon-enhanced dissociative electron attachment in SF₆ and its isotopic selectivity.- J. Chem. Phys. 1979, v.71, N10, p.3897-3907.
9. Mullen J.H. e.a. Measurement of electron attachment process in a high-temperature plasma.- Proc. IEEE, 1971,v.59, N4, p.605-609.
10. Куклин А.Е., Ханов Ю.И. Константы скоростей реакций образования и тушения эксиплексных молекул /Институт автоматики и электрометрии.- Препринт /ИАЭ СО СССР: N301.- Новосибирск, 19866 с.24.

SUMMARY

The plasma parametrs calculation is made for He-Kr-F₂ and He-Kr-SF₆ mixture. The temperature dependence of ion-ion recombination constants and negative ion formation constants is found. The dependence of eximer molecules formation from Kr, F₂, SF₆ concentration and from plasma temperature is investigated in the region of 10¹⁴-10¹⁷ sm⁻³ and 0,1-1,2 ev. The optimal initial plasma parametrs area is found for the formation of $B^2\Sigma_{1/2}^+ \rightarrow X^2\Sigma_{1/2}^+$ V inverse population in KrF* more than 10¹²sm⁻³.